沢一

郎

庴

# 可視および赤外分光エリプソメトリーによる 液晶配向膜の異方性測定

# Characterization of Rubbed Polyimide Film by Visible and Spectroscopic-Infrared Ellipsometry

# Ichiro HIROSAWA

Rubbed polyimide films are widely used to uniformly align liquid crystal molecules in liquid crystal displays. Characterization of polyimide molecular orientation of rubbed film has been widely interested, however, characterizing method has not been established. I applied ellipsometry with He-Ne laser and infrared spectroscopic ellipsometry to characterize polyimide molecular orientation. With using the estimated thickness of the upper molecular oriented layer and the lower random layer of rubbed polyimide film by ellipsometry of He-Ne laser, orientation of each function group of polyimide can be determined by infrared spectroscopic ellipsometry.

**Key words:** ellipsometry, infrared spectroscopic ellipsometry, molecular orientation, polyimide film, liquid crystal display

多くの液晶ディスプレイでは,液晶分子に印加する電場 と液晶配向膜(配向膜)とよばれる有機薄膜(通常はポリ イミド薄膜)により、液晶配向を制御して画像を表示する。 twisted nematic (TN)  $\in -F$ , super twisted nematic (STN) モード, in-plane switching (IPS) モードなどの ディスプレイでは,ポリイミド膜の分子を配向させるため に膜表面を布で擦るラビングが行われる. 配向膜は, 膜の ポリイミド分子と液晶分子との分子間相互作用により液晶 配向を制御するため,配向膜の状態は液晶ディスプレイの 品質に大きな影響を与える.したがって、ポリイミド膜の 分子配向評価は膜厚や平坦性と並んで重要な評価項目であ る. 従来から配向膜の分子配向評価は多くの関心を集め, 複屈折位相差測定<sup>1)</sup>,赤外吸収の二色性<sup>2)</sup>,微小角入射X 線散乱<sup>3,4)</sup>, sum frequency generation (SFG:波数和)や second harmonic generation (SHG: 第二高調波) などの 非線形光学効果5)による報告がある。特に簡便に測定でき る複屈折位相差測定や赤外吸収による評価が数多く試みら れているが<sup>1,2)</sup>,液晶パネルのガラス基板は赤外線が透過し

ないうえ、ガラス自身がわずかな複屈折性を有するため、 どちらの方法も配向膜評価への適用は困難である。一方、 反射光の偏光状態はガラス基板自身の複屈折性による影響 が少ないうえに膜の屈折率変化にも敏感であることから、 反射光偏光状態に現れる異方性を測定で配向膜の分子配向 状態評価が可能と考えられる<sup>6,7)</sup>.本稿では、可視および赤 外域<sup>8)</sup> での反射光の偏光測定による配向膜評価の検討結果 について報告する.

### 1. 反射光の偏光状態に現れる異方性

通常,配向したポリイミド分子は広い波長域で異方的な 誘電率を有する.このため,試料の誘電率が敏感に反映さ れる反射光の偏光状態の異方性を測定することにより,配 向膜の分子配向に関する知見が得られることが期待され る.図1(a),(b)は,ガラス基板(複屈折がごく小さいコ ーニング7059,屈折率1.527)に直接製膜された配向膜に 入射角50°でHe-Neレーザーを入射して測定した反射光 の偏光状態である.試料方位は,入射光の試料面内成分と

財団法人高輝度光科学研究センター(〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1) E-mail: hirosawa@spring8.or.jp



図1 He-Ne レーザーを光源としたエリプソメーターにより 測定したガラス基板上の配向膜からの反射光の偏光状態((a) が  $\Delta$ , (b) が  $\psi$ ). 図中の $\bigcirc$ は測定値,曲線は計算値を示す.

ラビング処理の向きが一致した方位を0°とし、入射光側か ら見て試料が反時計回りに回転する方向をプラス方向と定 義している。これらの図が示すように、△(複素振幅反射率 どちらにも反転非対称な試料方位依存性が明瞭に観測され ている.図1(a)にみられるように反射光では △の最大値 と最小値の差が約9°である一方, 試料表面に垂直に He-Ne レーザーを入射して測定した複屈折位相差は0.9°にす ぎず、反射光の偏光状態に現れる異方性の測定は複屈折位 相差測定より高感度な方法である。反射光の⊿および↓ の異方性は、複屈折位相差と同様に、誘電率の異方性が大 きいほど,もしくは異方性を有する膜が厚いほど大きくな ると考えられる。また、図1(a)、(b) にみられる反転非対 称性は、配向膜の誘電率テンソルの主軸が膜表面に対して 傾いていることを示している. このような特徴をもつ測定 データを, Berreman の 4×4 行列法にもとづいたモデル計 算により再現することを試みた<sup>9</sup>.

ポリイミド膜をラビングした場合,表面近傍の数 nm から 10 nm 程度部分がほぼ均一に配向していると報告され ていることから<sup>20</sup>,ポリイミド分子が配向した領域を単軸 異方性媒質,基板側の無配向部分を等方性媒質と近似す る.この近似では,配向膜の状態は配向領域の膜厚 ( $d_u$ ), 異常光と常光に対応する主誘電率 ( $\epsilon_e$ ,  $\epsilon_o$ ),誘電率テンソ ル主軸の表面に対する傾き角 ( $\theta$ ),面内方位角 ( $\alpha$ ),無配 向部の等方的な誘電率 ( $\epsilon_i$ ),膜厚 ( $d_i$ )の合計7つのパラ メーターで記述される.ここで,無配向領域の誘電率と配 向領域の誘電率との間には 3 $\epsilon_i^2=2\epsilon_e^2+\epsilon_o^2$ が成立すると 考えられるため,配向膜の状態を表す独立なパラメーター は6種であり,誘電率が複素数の場合は独立なパラメータ ーは8個である.

Berreman の 4×4 行列法においては、入射光、反射光、 透過光の一般化電場ベクトル  $\psi$ i,  $\psi$ r,  $\psi$ t を、それぞれの 電場ベクトルのs、p 成分 (Eis, Eip), (Ers, Erp), (Ets, Etp) をもちいて  $\psi$ i=<sup>t</sup>[Eipcos  $\eta$  Eip Eis Eiscos  $\eta$ ],  $\psi$ r=<sup>t</sup>[-Erpcos  $\eta$  Erp Ers Erscos  $\eta$ ],  $\psi$ t=<sup>t</sup>[Etpcos  $\xi$ Etp Ets NsEtscos  $\xi$ ] と定義する (括弧左肩のt は転置 行列であることを示す). ここで、 $\eta$  は入射角、 $\xi$  は基板内 を進行する光の屈折角であり、スネルの法則に従い基板の 屈折率 Ns と sin  $\eta$ /sin  $\xi$ =Ns の関係を有する. 光の角周 波数が  $\omega$  であるとき、入射光、反射光、透過光の一般化電 場ベクトル  $\psi$ i、 $\psi$ r、 $\psi$ t は、配向膜表面近傍の異方的な領 域と基板側の等方的な領域の誘電率テンソルに依存した4 行 4 列の行列  $\Delta_{u}$ 、 $\Delta_{i}$  をもちいて

$$L_{\rm u} = \exp\left(-\mathrm{i}\omega d_{\rm u}\Delta_{\rm u}\right) \tag{1}$$

$$L_1 = \exp(-i\omega d_1 \Delta_1) \tag{2}$$

と表される4行4列の行列 Lu,L1 により

$$\psi t = L_1 L_u (\psi i + \psi r)$$

なる関係で結ばれている<sup>8)</sup>. なお,配向膜の異方性領域に 対応する行列  $\Delta_u$ の各行列要素  $\Delta_{ij}$  は試料方位  $\phi$  において,

$$\begin{aligned} \mathcal{\Delta}_{11} = \mathcal{\Delta}_{22} = -\left(\boldsymbol{\varepsilon}_{e} - \boldsymbol{\varepsilon}_{o}\right)\sin\eta\sin\theta\cos\theta\cos\left(\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\alpha}\right) / \\ \left(\boldsymbol{\varepsilon}_{e}\sin^{2}\theta + \boldsymbol{\varepsilon}_{o}\cos^{2}\theta\right) & (4.1) \\ \mathcal{\Delta}_{12} = 1 - \sin^{2}\eta / \left(\boldsymbol{\varepsilon}_{e}\sin^{2}\theta + \boldsymbol{\varepsilon}_{o}\cos^{2}\theta\right) & (4.2) \\ \mathcal{\Delta}_{13} = \mathcal{\Delta}_{42} = -\left(\boldsymbol{\varepsilon}_{e} - \boldsymbol{\varepsilon}_{o}\right)\sin\eta\sin\theta\cos\theta\sin\left(\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\alpha}\right) / \\ \left(\boldsymbol{\varepsilon}_{e}\sin^{2}\theta + \boldsymbol{\varepsilon}_{o}\cos^{2}\theta\right) & (4.3) \end{aligned}$$

$$\mathcal{\Delta}_{21} = \varepsilon_0 \left[ \varepsilon_0 - (\varepsilon_e - \varepsilon_0) \cos^2 \theta \cos^2 (\phi - \alpha) \right] /$$

$$\left( \varepsilon_e \sin^2 \theta + \varepsilon_0 \cos^2 \theta \right) \tag{4.5}$$

$$\mathcal{\Delta}_{23} = \mathcal{\Delta}_{41} = -\varepsilon_{o} \left(\varepsilon_{e} - \varepsilon_{o}\right) \cos^{2} \theta \cos(\phi - \alpha) \sin(\phi - \alpha) / \\ \left(\varepsilon_{e} \sin^{2} \theta + \varepsilon_{o} \cos^{2} \theta\right)$$
(4.6)

(3)

$$\mathcal{\Delta}_{34} = 1$$

$$\mathcal{\Delta}_{43} = \boldsymbol{\varepsilon}_{0} [\boldsymbol{\varepsilon}_{e} - (\boldsymbol{\varepsilon}_{e} - \boldsymbol{\varepsilon}_{0}) \cos^{2} \theta \cos^{2} (\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\alpha})] /$$

$$(4.7)$$

( $\varepsilon_{e} \sin^{2} \theta + \varepsilon_{o} \cos^{2} \theta$ )  $-\sin^{2} \eta$  (4.8) となる.等方領域の行列  $\Delta_{I}$ の要素は、上の式の  $\varepsilon_{e}$ ,  $\varepsilon_{o}$ に  $\varepsilon_{I}$ を代入して得られる.反射光の偏光状態 (Ers, Erp) は、 入射光 (Eis, Eip) と透過光 (Ets, Etp) の間に成立する スネルの法則と一般化電場ベクトルの関係式(3)より、入 射光 (Eis, Eip) と入射角  $\eta$ 、および  $\varepsilon_{e}$ ,  $\varepsilon_{o}$ ,  $\phi$ ,  $\alpha$ ,  $\theta$  の 関数で表すことができる<sup>9</sup>.

#### 1.1 可視域での反射光の偏光状態

He-Ne レーザーのように可視域の光源では、配向膜に よる光の吸収がごく小さく、 $\epsilon_{e}$ 、 $\epsilon_{o}$ および $\epsilon_{i}$ を実数として 扱うことが可能であるため, 配向膜の状態を記述する独立 なパラメーターは6個である。可視域では、偏光状態から 等方性膜の屈折率や膜厚を決定するのと同じようにして, 偏光状態  $\Delta$ ,  $\psi$  の平均値から  $\epsilon_i$  と膜全体の厚さ  $(d_u + d_i)$ の近似値を決定できる. さらに, 異方性領域が厚くなるほ ど、もしくは $\epsilon_{e}$ と $\epsilon_{o}$ の差が大きくなるほど、 $\Delta$ や $\psi$ の最 大値と最小値の差に代表される偏光状態の異方性は大きく なる.しかし, 膜厚の変化は, 膜内の光路長の変化を通じ て偏光状態に影響を与える一方、誘電率の変化は光路長ば かりでなく表面および界面での反射率に変化をもたらすた め, 膜厚変化と誘電率変化では偏光状態に与える影響が異 なる<sup>10)</sup>。また,誘電率テンソル主軸の傾き角θは偏光状態 の反転対称性の破れとして反映される。傾き角が0°(膜面 に平行) であれば、偏光状態は 180°の回転対称性を有し、 傾き角が 90°(膜面に垂直) では偏光状態は入射方位によら ず一定となる。傾き角が0°より大きく90°未満の場合に、 反転非対称な方位依存性を示す10).

以上のように、配向膜の状態を表す6つのパラメーター が偏光状態に与える影響はそれぞれ異なっているため、行 列 $\Delta_u$ が互いに独立になる3方位(例えば $\phi=0^\circ$ ,45°,90°) での6個の測定値(3組の $\Delta \ge \psi$ )から配向膜の状態を記 述するパラメーターを決定できると期待される(ただし、 周期解が存在する)<sup>10)</sup>.しかしながら、配向膜の状態を表す パラメーターと反射光の偏光状態の関係は非線形性が強 く、解析解を得ることは容易ではない.そこで、非線形最 小二乗法をもちいて計算値が測定値を再現するようにパラ メーターを最適化することで解の推定を行う.図1(a), (b)の曲線は、測定値より推定されたパラメーター(配向 領域の異常光誘電率 $\epsilon_e$  2.72、常光誘電率 $\epsilon_o$  2.57、厚さ  $d_u$  42.1 nm、誘電率テンソルの傾き角 $\theta$  30°、無配向領域 膜厚  $d_i$  53.1 nm、誘電率 $\epsilon_i$  2.62)より計算した結果であ る.図1(a),(b)に示すように、計算値は測定値の特徴を よく再現し、単軸異方性媒質と等方性媒質の2層構造が配 向膜のよい近似であることを示している。さらに、これら のパラメーターから計算される透過光の複屈折位相差は測 定値の0.90°にほぼ等しい0.93°となることも、2層構造 による近似や得られたパラメーターが妥当であることを示 している。

なお、実際の液晶ディスプレイでは、配向膜とガラス基 板の間に透明電極膜などの下地構造が存在する。たとえ ば、基板、透明電極膜、配向膜からなる試料の場合、透明 電極膜に対応する行列を $L_{\rm tro}$ で表すと、式(3)は

$$p_{\rm T} = L_{\rm ITO} L_{\rm I} L_{\rm u} \left( \psi_{\rm I} + \psi_{\rm T} \right) \tag{5}$$

となる.配向膜以外の層の厚さと誘電率が既知であれば, 式(5)をもちいて,実際の液晶ディスプレイパネルにお いても測定された偏光状態から,配向膜の構造を決定する ことが可能である<sup>11)</sup>.

#### 1.2 赤外域での反射光の偏光状態

赤外線領域では光と分子振動との相互作用が強く、官能 基固有の共鳴吸収を生じるため,赤外線吸収分光は定性分 析などに広く利用されている。このため、反射赤外線の偏 光状態にも、官能基の共鳴吸収に対応した特徴的な構造が 現れることが期待される。図2(a),2(b)は、図1(a),1 (b) と同じ試料を Joban-Ybon 製のフーリエ変換型赤外分 光エリプソメーターで測定して得られた反射赤外線の偏光 状態 △, ψ の波数依存性である. このポリイミドは,1つの 窒素原子(N)と4つの炭素原子(C)により構成される5 員環(イミド環)2組と6個の炭素原子からなるベンゼン 環4組が酸素原子をはさんで直線的に結合した構造をも ち,分子鎖の向きに並んだエーテル (C-O-C) やベンゼン, 分子鎖と直交したイミド環のカルボニル (-C=O) など,赤 外線の共鳴吸収を担う官能基を有する.図2(a),(b)に示 す通り,期待通りにエーテル (1248 cm<sup>-1</sup> 付近),ベンゼン (1504 cm<sup>-1</sup> 付近),カルボニル (1712 cm<sup>-1</sup> 付近) などの共 鳴吸収に対応する波数近傍で ↓ が極小になるなど,反射 赤外線の偏光状態にも特徴的な構造が観測されている。図 3 (a), (b) は、ベンゼンの共鳴吸収波数付近で ψ が極小に なる波数 1504 cm<sup>-1</sup> での偏光状態 △, ψ の入射方位依存性 である. 図3(a), (b) が示すように, 赤外線の偏光状態に おいても異方性が観測され、ベンゼンが配向していること がわかる.このように赤外分光エリプソメトリーの測定に よって, 官能基ごとの配向に関する知見が得られる. ポリ イミド分子鎖を構成するそれぞれの官能基の配向が明らか になることによって,ポリイミド分子鎖の配向の推定が可 能となる.液晶分子は、液晶配向膜表面近傍のポリイミド



分子鎖との分子間相互作用により配向すると考えられるた め、ポリイミド分子鎖配向に関する直接的な知見が得られ る赤外分光エリプソメトリーは、液晶配向膜の評価方法と して有力な手法と考えられる。

#### 1.3 官能基の配向

配向膜による吸収が顕在化する赤外領域では,誘電率を 複素数として扱うことが必要となる.この場合,未知のパ ラメーターは,誘電率  $\epsilon_{e}$ ,  $\epsilon_{o}$ の実部と虚部の4個と配向領 域と無配向領域の厚さ,および配向領域の誘電率テンソル 主軸の傾きと面内方位の8個となる.誘電率が複素数にな る赤外域においても,入射方位に対する $\Delta \ge \psi$ の平均値 は,膜の誘電率の平均値と膜全体の厚さから計算される値 に近似的に一致する.誘電率が実数である可視光の場合 は、 $\Delta \ge \psi$ の平均値と膜の誘電率の平均値と膜全体の厚 さは周期解を除外すれば1対1に対応するが,誘電率が複 素数となる赤外域では未知のパラメーターが3個になるた め,膜の誘電率の平均値と膜全体の厚さを決定できない.



図3 波数1504 cm<sup>-1</sup> での配向膜の反射赤外線の偏光状態 ((a) が Δ, (b) がψ). 図中の○は測定値, 曲線は計算値を示す.

赤外域のパラメーター8個を推定する方法として, 偏光 状態の入射方位依存性の入射角分散もしくは波数分散測定 が考えられる.しかし,式(4.1)~(4.8)に示すように,入 射角 $\eta$ に対する依存性を有する行列要素は16個中の6個 に限られるうえ,この6個中の4個の要素が微小量 $\epsilon_e - \epsilon_o$ を係数とするため,誘電率や膜厚の差が偏光状態の入射角 依存性に与える変化が小さく,入射角分散測定では感度が 期待できない.他方,波数分散測定は配向部分および無配 向部分の厚さが偏光状態に直接的な影響を与える一方,誘 電率の波長分散も同時に推定する必要がある.このため, 多数の官能基による共鳴吸収が存在する赤外域では,パラ メーター推定が煩雑になる.

一方, 膜厚が既知な等方性膜の場合は, 偏光状態から誘 電率の実部と虚部を決定できるのと同様に, 複素誘電率が 異方性をもつ場合も偏光状態の入射方位依存性より複素誘 電率テンソルを決定できると期待される.そこで, 配向膜 の吸収を無視できる可視光領域で決定された配向領域およ び無配向領域の膜厚 (d<sub>u</sub>, d<sub>l</sub>)をもちいて,赤外域でのパラ メーター推定を行う.

さらに、誘電率の分散関係の特徴を利用して、未知パラ メーターの数を減らすことが可能である。共鳴吸収波数 ω<sub>0</sub> 近傍での複素誘電率の波数分散は

$$\varepsilon \propto \omega / (\omega^2 - \omega_0^2 + i\Gamma\omega) \tag{6}$$

と表され<sup>12)</sup>,  $\omega = \omega_0$  では誘電率が純虚数となるため,誘電率の実部は配向領域,無配向領域ともに同じ値になって未知パラメーターが1つ減る.

共鳴吸収波数  $\omega_0$  は、測定された偏光状態の波数依存性 から、以下のようにして決定される.液晶配向膜の厚さは 通常 100 nm 程度以下であるため、薄膜近似<sup>13)</sup>(膜厚が赤 外線の波長と比較して十分に小さいとき、基板上の薄膜か らの反射赤外線の偏光状態  $\Delta$ ,  $\psi$  と基板からの反射赤外線 の偏光状態  $\Delta$ s,  $\psi$ s それぞれの差  $\Delta - \Delta$ s,  $\psi - \psi$ s が、膜の 誘電率の実数部および虚数部に近似的に比例)が成立し、 膜の誘電率の虚数成分は主として  $\psi$  に反映される.このた め、 $\psi$  が極小となる波数が共鳴吸収波数  $\omega_0$  となる.したが って、 $\psi$  が極小となる波数 1504 cm<sup>-1</sup> では、決定すべき未 知のパラメーターは  $\varepsilon_e$  と  $\varepsilon_0$  の実部、および主誘電率テン ソル主軸の極角と方位角の5つであり、測定された偏光状 態の方位依存性からパラメーターを推定できる.

図3(a),(b)に、 $\psi$ が極小となるベンゼンの共鳴吸収波数1504 cm<sup>-1</sup>での偏光状態の測定値と、上記の方法で推定したパラメーターから得られた計算値を示す.この例では、誘電率の実数部は2.63、虚数部は-2.83i と-1.44i、誘電率テンソル主軸の傾き角は35°と推定された.ベンゼン環は可視域での屈折率を担う $\pi$ 電子を高い密度で有するため、このポリイミドの場合は、波数1504 cm<sup>-1</sup>の主誘電率座標軸の傾き角35°と He-Ne レーザーを光源とした可視域の測定より求めた傾き角30°とが互いに近い値となっている.測定したポリイミドは複数のベンゼン環が主鎖中に並んでいるため、ベンゼンの共鳴吸収波数1504 cm<sup>-1</sup>での誘電率テンソル主軸の傾き角は、ポリイミド分子主鎖の平均的な傾き角に相当すると考えられる.

# 2. ま と め

ここでは、液晶配向膜の無配向部分を等方性媒質として 扱ったが、X線散乱の測定などにより分子鎖は基板面に対 してほぼ平行に配向することが明らかにされているた め<sup>14)</sup>、基板界面近傍は誘電率テンソル主軸が基板面法線と 平行な単軸異方性媒質、表面近傍の配向部分を2軸異方性 媒質とするほうがより妥当な近似である.この場合、液晶 配向膜の状態を表すパラメーターはさらに多くなるが, 偏 光状態の入射方位依存性の入射角分散測定によりパラメー ターを推定できる可能性がある.

以上のように,可視光のエリプソメトリーと赤外分光エ リプソメトリーの組み合わせにより,液晶配向膜の配向部 分と無配向部分の厚さおよび官能基ごとに配向の極角,方 位角成分を推定することが可能である。特に赤外分光エリ プソメトリーは,通常の赤外吸収分光測定で必要な窒素パ ージなどの必要がなく簡便に測定できるため,有望な液晶 配向膜の評価手法になりうると考える。

# 文 献

- N. A. J. M. van Aerle, M. Barmentlo and R. W. J. Hollering: "Effect of rubbing on the molecular orientation within polyimide orienting layers of liquid-crystal displays," J. Appl. Phys., 74 (1993) 3111-3120.
- K. Sawa, K. Sumiyoshi, Y. Hirai, K. Tateishi and T. Kamejima: "Molecular orientation of polyimide films for liquid crystal alignment studied by infrared dichroism," Jpn. J. Appl. Phys., 33 (1995) 6273-6276.
- M. F. Tony, T. P. Russell, J. A. Logan, H. Kikuchi, J. M. Sands and S. K. Kumar: "Near-surface alignment of polymers in rubbed film," Nature, 374 (1995) 709–711.
- I. Hirosawa, N. Sasaki and H. Kimura: "Molecular orientation of rubbed polyimide film determined by grazing incidence X-ray diffraction," Jpn. J. Appl. Phys., 38 (1999) L583-L585.
- X. Wei, X. Zhuang, S.-C. Hong, T. Goto and Y. R. Shen: "Sum-frequency vibrational spectroscopic study of a rubbed polymer surface," Phys. Rev. Lett., 82 (1999) 4256-4259.
- I. Hirosawa: "Method of characterizing rubbed polyimide film for liquid crystal display devices using reflection ellipsometry," Jpn. J. Appl. Phys., 35 (1996) 5873–5875.
- I. Hirosawa: "Relation between molecular orientation and rubbing strength observed by reflection ellipsometry," Jpn. J. Appl. Phys., 36 (1997) 5192–5196.
- I. Hirosawa: "Application of infrared ellipsometry to characterize molecular orientation of rubbed polyimide films," *Int. Display Workshop (IDW) '03 Proc.* (2003) pp. 185–188.
- 9) D. W. Berreman: "Optics in stratified and anisotropic medial 4×4-matrix formulation," J. Opt. Soc. Am., 62 (1972) 502-510.
- 10) 廣沢一郎: "液晶配向膜の表面異方性",液晶,7 (2003) 159-169.
- S. Itoh and I. Hirosawa: "Observation of an optical anisotropy of rubbed polyimide film on actual display panel," Mol. Cryst. Liq. Cryst., 367 (2001) 745-750.
- 12) R. Ossikovski, H. Shirai and B. Drevillon: "In-situ investigation of amorphous silicon-silicon dioxide interface by infrared ellipsometry," Appl. Phys. Lett., 64 (1994) 1815-1817.
- R. Benferhat, B. Drevillon and P. Robin: "IR Ellipsometry study of oriented molecular monolayers," Thin Solid Films, 156 (1988) 295–305.
- 14) I. Hirosawa: "Characterization of polyimide molecular orientation of LC alignment film by grazing incidence X-ray diffraction," *Int. Display Workshop (IDW) '04* (2004) pp. 179-182.

(2004年12月9日受理)

光